

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание			
		Устройства								
		A1	VRB4812ZP-6WR3 ф. MORNSUN				1			
		A2	GeoS-5M ф. Geostar				1			
		Преобразователи неэлектрических величин								
Справ. №	BL1	TEM5510FX01				1				
	BL2	APA3010P3BT				1				
	Конденсаторы									
	C1	керам., чип 0603, NPO, 50В, 1нФ ±0.1нФ				1				
	C2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				1				
	C3	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50В, 0.18мкФ ±2%)				1				
	C4	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16В, 47мкФ ±10%)				1				
	C5	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16В, 47мкФ ±10%)				1				
	C6	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100В, 470мкФ ±20%, низк. имп.)				1	не старше 1 года			
Подп. и дата	C7	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16В, 1000мкФ ±20%)				1				
	C8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+50...-20)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ ф. АО «Электонд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7В, 100Ф +50...-20%)				1				
	C9-C24	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				58				
Взам инв. №	Микросхемы									
	DA1	МОС3063М (детектор нуля)				1				
	DA2	TPS561201DDC ф. Texas Instruments				1				
	доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2А)									
Подп. и дата	доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3А)									
	DA3	LP5907MFX-3.3 ф. Texas Instruments				1				
						BCAD.123456.001 ПЭЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Инв. № подл.	Разраб.	Иванов И.И.		19.01.2025	ВоМ Converter отладочный проект AD			Лит.	Лист	Листов
	Проверил	Петров П.П.		19.01.2025					1	6
	Н. контр.	Зюзина В.Н.		19.01.2025	Перечень элементов			ООО "НИИ БАЦА"		
	Утв.	Горшков А.С.		19.01.2025						

[illegible]

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание
		Устройства сигнальные				
HG1		CC56-12SRWA ф. Kingbright			1	
HL1		KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)			1	
HL2		KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)			1	
HL3		KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)			1	
HL4		KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)			1	
HL5		KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)			1	
HL6		XPCWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000К, CRI75, 73.9лм [350мА])			1	
HL7		SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)			1	
HL8		KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)			1	
HL9		AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)			1	
J1		Перемычка чип 0402			1	
		Реле				
Подп. и дата		K1 RZ03-1A4-D012 ф. TE Connectivity			1	
		K2 T9GV2L24-12 ф. TE Connectivity			1	
		K3 RT214012 ф. TE Connectivity			1	
		K4 V23105A5476A201 ф. TE Connectivity			1	
Инв. № дудл.						
		Катушки индуктивности				
		L1 чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			1	
		L2 SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5A)			1	
Взам инв. №		L3-L5 чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			3	
		L6-L8 SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5A)			3	
		L9, L10 SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6A)			2	
		L11 SRR0604-100ML ф. Bourns (10мкГн ±20%, 1.3A)			1	
Подп. и дата		L12 SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6A)			1	
		Резисторы				
		R1 чип 0603, 10кОм ±5%			1	
Инв. № подл.						BCAD.123456.001 ПЭЗ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	
					3	

Поз. обозначение						Наименование	Кол.	Примечание
R2						чип 0603, 47кОм ±0.5%, ±25ppm/°C	1	
R3						RV0805JR-071ML ф. YAGEO (чип 0805, 400В, 10кОм ±5%)	1	
R4-R6						чип 0603, 100кОм ±5%	3	
R7, R8						чип 0603, 200кОм ±5%	2	
R9-R12						чип 0603, 300кОм ±5%	4	
R13						чип 0603, 470кОм ±5%	1	
R14-R19						чип 0603, 1кОм ±1%	48	
RK1						NCP18XQ102J03RB ф. Murata (чип 0603, 1кОм ±5%)	1	
RK2						TFPT0805L1000FV ф. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1	
RP1						3006P-1-103 ф. Bourns (10кОм ±10%, , подстроечный, лин. хар-ка)	1	
						Устройства коммутационные		
SA1						CHS-01TA ф. Copal Electronics Inc.	1	
SA2						SWD-08L	1	
SA3						MS-22D18 (двухжкобий)	1	
SA4						GPTS203211B ф. CW Industries	1	
Подп. и дата		SA5				SSSF012100	1	
		SA6				PN12SHNA03QE ф. C&K	1	
		SB1				DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный)	1	
Инв. № дудл.		T1				Трансформатор HX1188NL ф. Pulse	1	
						Диоды		
Взам. инв. №		VD1				BAS316 (100В, 250мА, корпус SOD-323)	1	
		VD2				BAT20JFILM (Шоттки, 23В, 1А, корпус SOD-323)	1	
		VD3				BZT52H-B13 (13В ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1	
		VD4				BB545E7904 ф. Infineon	1	
Подп. и дата		VD5				BAT54AFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)	1	
		VD6				BAT54CFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)	1	
		VD7				BAT54SFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)	1	
Инв. № подл.								
						BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			4

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
		Тиристоры					
VS1					1		
VS2		TYN412RG ф. STMicroelectronics (400В, 12А, 15мА)			1		
VS3		TMMDB3TG ф. STMicroelectronics (двунаправ., 32В, 2А, 15мкА)			1		
VS4		BTA24-600BWRG			1		
		Транзисторы					
VT1		BCR108 (диполярный цифровой)			1		
VT2		IRLML2030			1		
VT3		BC817			1		
VT4		BCR158 (диполярный цифровой)			1		
VT5		IRLML5103			1		
VT6		BC807			1		
VU1		Оптомара LTV-357T			1		
		Соединители					
X1		15EDGRC-3.5-04P ф. Degson			1		
X2		5035000993 ф. Molex			1		
		доп. замена 5035000991					
X3		292303-1 ф. TE Connectivity			1		
		Фильтры					
ZC1		WCM4532F2SF-142T20-HI ф. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.			1		
		(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)					
ZF1		MMZ1608B102C ф. TDK (фер. дус., чип 0603, 1кОм ±25% [100МГц],			1		
		600мОм, 300мА)					
ZQ1		FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ppm, фунд., 18пФ,			1		
		1000м, -40...+85°C)					
ZQ2		ABS07-32.768KHZ-T ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ppm, 12.5пФ,			1		
		70кОм, -40...+85°C)					
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
							5
		Изм.	Лист	№ докум.			Подп.

[illegible]